小型多価イオン源による多価イオンビームの特性

中村信行研究室 金原達彦

1. 背景・目的

多価イオンとは、原子から電子を2個 以上取り除いたイオンであり、太陽コロ ナや核融合炉などの高温プラズマ中に存 在する。多価イオンは反応性が非常に高 く、固体表面と衝突させることでナノサ イズの構造変化を発生させる。また、EUV (Extreme Ultraviolet)リソグラフィ光源 などへの、様々な応用が期待されている。

我々の研究室では、Tokyo Electron Beam Ion Trap (Tokyo-EBIT) [1] と呼ば れる大型イオン源と、 Compact EBIT(CoBIT) [2] と呼ばれる小型のイオン 源を用いて多価イオンの研究を行ってい る。Tokyo-EBIT は高価数の重元素多価イ オンの生成が可能である反面、中程度の 価数の多価イオンの生成には過剰性能で ある。CoBIT はそのような中程度の価数 の多価イオンを効率的に生成するよう設 計されており、これまで分光研究に用い てられてきた。しかし、CoBIT には生成し た多価イオンをビームとして引き出すビ ームラインが無く、Tokyo-EBIT で行って いるような衝突実験が不可能であった。 そこで我々は CoBIT から引き出した多価 イオンの衝突実験を可能とする新規ビー ムラインの構築を行っている。

本研究では、CoBIT より引き出したイ オンビームのエミッタンスを測定するこ とでビームの特性を調べた。

2. 装置

2.1 EBIT

我々の研究室で用いているイオン源で ある電子ビームイオントラップ(EBIT) による多価イオン生成の原理を Fig.1 に 示す。EBIT は主に、電子銃、ドリフトチ ューブ(DT)、電子コレクターから構成さ れており、DT の周りには超伝導コイルが 配置されている。DT1・2・3の領域では、 軸方向には DT に印加される電圧により 形成する井戸型ポテンシャル、径方向に は電子ビームの空間電荷ポテンシャルに よりイオンをトラップする。DT 内部にト ラップされたイオンは強磁場で圧縮され た電子ビームにより逐次電離が進み、多 価イオンが生成される。

この装置では単一の価数のイオンのみ を生成することは難しく、トラップ領域 内は様々なイオンが入り混じった状態で ある。よって、衝突実験を行うには価数分 別能力を持つ装置を用いることで、必要 な価数のイオンのみを取り出す必要があ る。



Fig.1 多価イオンの生成方法

2.2 新規ビームライン

衝突実験用新規ビームラインはアイン ツェルレンズ、静電偏向器(ベンダー)、ウ ィーンフィルターの 3 つの要素で構成さ れている。まず、CoBIT で生成された多価 イオンはアインツェルレンズにより集束 させられる。次にベンダーにて多価イオ ンのみを 90 度曲げることにより、イオン 源内で発生する軟 X 線と多価イオンを分 離する。最後にウィーンフィルターによ り様々な価数を持ったイオンを分別し、 選択した価数のイオンのみを引き出す。



Fig.2 新規ビームライン

3. 実験原理

3.1 エミッタンス

ビームの特性を評価するにあたり、今 回はイオンビームのエミッタンスを測定 した。エミッタンスとは荷電粒子ビーム の集束特性を記述するために用いられる 物理量であり、横軸をビーム軸からの距 離、縦軸をビームの発散角とした Fig.3 の ような位相図上において、ビームの構成 粒子が占める面積をπで割った値により 定義される。

エミッタンスは、ビーム源により決ま り、レンズによる収束作用などでは不変 である。



Fig.3 位相図

3.2 エミッタンス測定

エミッタンス測定法の一例を Fig.4 を 用いて説明する。ビーム軸からスリット までの距離を r_{i},r_{i-1} とし、検出面でのビー ムの到達位置を h_{i},h_{i-1} とすると、ビームの 発散角 θ_{i}, θ_{i-1} は近似的に

$\boldsymbol{\theta}_{i} = (h_{i} - r_{i})/L$

$$\theta_{i-1} = (h_{i-1} - r_{i-1})/L$$

と計算することができる。スリット位置 rを変化させながら発散角 θを上記の式 より求めることで位相図が作成され、エ ミッタンスの値を求めることができる。



Fig.4 エミッタンス測定

この方法によりエミッタンスを測定す るために、Fig.5のような測定装置を構築 した。この測定では、静電偏向器の下流に 幅 0.2mm のスリットと位置有感型検出器 (PSD)を配置することで、CoBIT より引き 出したビームのうちスリットを通過した 部分のビームの拡がりを測定ことができ る。この測定をスリットの位置を変更し ながら多価イオンビーム全体に対して行 うことで位相図が得られる。

4. 実験結果

得られた位相図を Fig.6 に示す。これを 水平にし、拡大したものが Fig.7 である。 Fig.7 に描かれた楕円の面積を求めるこ とにより、多価イオンビームのエミッタ ンスが~5mm・mrad 程度であることが分 かった。また、スリットを通過したイオン ビームの強度分布を調べたところ、ビー ムの直径が約 18mm 程度であることが判 明した。



Fig.6 多価イオンビームの位相図と強度分布



Fig.7 多価イオンビームの位相図

5. 考察

実験結果より診断したビームのエミッ タンスは~5mm・mrad であった。この 値を他の EBIT と比較すると、Table.1 よ り他の EBIT 装置と同程度のエミッタン スであることがわかる。

一方で、ビームの直径が約 18mm 程度 であることは、一般的な EBIT からの多 価イオンビームの直径が数 mm 程度であ ることや、ウィーンフィルターのスリッ ト部の幅が 0.2mm であることを考慮する と大きすぎると考えられる。

| イオン源 | エミッタンス 〔mm・mrad〕 |
|----------------------|---------------------|
| Dresden EBIT [3] | ~10 |
| LNNL EBIT [4] | ~1 |
| Stockholm R-EBIT [5] | 7.2 |
| TITAN EBIT [6] | 15.7 ± 0.5 |
| REX EBIT [7] | ~10 |

Table.1 他の EBIT のエミッタンス

6. まとめと今後の展望

今回の結果より、CoBIT から引き出さ れた多価イオンビームのエミッタンスは 良好であると考えられるが、ビームの直 径は18mm 程度と大きく、現行のレンズ では十分に集束できていないことがわか った。よって、今後の展望としてビーム をより集束させるために、静電偏向器の 再設計、もしくは静電偏向器を通した後 にビームを集束させるための静電レンズ を取り付ける必要があると考えられる。 また、CoBIT内に設置しているアインツ エルレンズを含め、軌道計算を再度行 い、改造・改良を行う必要がある。

7. 参考文献

[1] Hirofumi WATANABE Characteristics of Tokyo Electron-Beam Ion Trap (1997)

[2] N.Nakamura Compact electron beam ion trap for spectroscopy of moderate charge state ions. (2008)

[3] DREEBIT

http://www.dreebit.com/en/ion_sources/

[4] R.E.Marrs Self-cooling of highly charged ions during extraction from electron beam ion sources and traps (1998)
[5] M.Hobein Optimization of the Stockholm R-EBIT for production and extraction of highly charged ions (2010)
[6] A.T.Gallant TITAN-EBIT - charge breeding of radioactive isotopes for high precision mass measurements (2010)
[7] Charge breeding system

http://isolde.web.cern.ch/isolde/REX-ISOLDE/rexebis.html